ABSTRACT


Keywords : 无
第四章 結論

4.1 多晶氮化鎵膜之成長結果

4.2 金半金紫外光感測器元件暗電流及照光後的電流比較

4.3 多晶氮化鎵應用於光電元件製作之潛力

4.3.1 多晶氮化鎵應用於火燄偵測器之研製

4.3.2 應用於多晶氮化鎵/多晶矽複合太陽電池之可行性研究

參考文獻

REFERENCES


20. 史光國 作者, MOCVD 成長MG摻雜P-GAN之特性(上);工業材料162期, 第一四五頁, (2000)。


24. M. OGAWA, M. FUNATO, T. ISHIDO, S. FUJITA AND S. FUJITA, THE ROLE OF GROWTH RATES AND BUFFER LAYER STRUCTURES FOR QUALITY IMPROVEMENT OF CUBIC GAN GROWN ON GAAS,
